

哈尔滨工业大学（深圳）2025 春学期电磁场期末试卷

考试时间：2025 年 5 月 10 日 13:30~15:30，满分 100 分，闭卷考试，允许使用计算器。

免责声明：本试卷为离开考场后的回忆版，不存在任何违反考试纪律的行为。

试卷回忆者：Gaster

一、填空题（每题 2 分共 12 分）

1. 传导电流、磁化电流、位移电流说法正确的是（）

- A 位移电流可以在真空、介质、导体中传播
- B 磁化电流
- C 传导电流、磁化电流、位移电流产生磁场性质相同
- D 位移电流能在导体中产生焦耳热

2. $\vec{A} = x^2 - 2xy\vec{e}_x + y^2 - 2yz\vec{e}_y + z(z - 2x + 1)\vec{e}_z$, \vec{S} 是球心在原点、半径为 ρ 的球面外侧，

求 \vec{A} 的在 \vec{S} 上的通量（）

- A. $4\pi\rho^2$; B. $-4\pi\rho^2$; C. $\frac{4}{3}\pi\rho^3$; D. $-\frac{4}{3}\pi\rho^3$

3. 关于极化，正确的是（）

- A 电介质的极化等效为极化电荷对介质的影响
- B 媒质的磁化一定会有磁化面电荷和磁化体电荷
- C 自然界的实体物质都是磁媒质
- D 极化

4. 同轴电缆内外导体的半径分别为 a 、 b ，介电常数为 ϵ ，圆柱带电 Q ，圆筒带电 $-Q$ ，在 ρ 处的电场能量密度为（）

5. 关于同轴电缆中的电磁能流，下列说法正确的是（）

- A 无内阻时，能流密度沿介质由电源向负载传播
- B 有内阻时，只有内导体有热损耗，外导体没有热损耗
- C 无内阻时，能流密度沿导体传播
- D 有内阻时，能流密度沿导体和介质由电源向负载传播

6. 下列恒定电场衔接条件说法正确的是（）

- A 理想电介质和导体表面，在导体侧 \vec{J} 存在法向分量
- B 在导体侧 \vec{E} 存在法向分量
- C 良导体到不良导体，分界面为等位面
- D 良导体到不良导体， \vec{J} 线垂直于分界面

二、电磁场的应用（8 分+8 分）

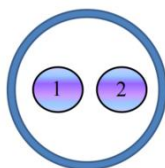
例1. 已知二芯对称的屏蔽电缆如图所示，测得导体1、2间的等效电容为 $0.018\mu\text{F}$ ，导体1、2相连时和外壳间的等效电容为 $0.032\mu\text{F}$ ，求各部分电容。

解：因为电缆对称，所以 $C_{10} = C_{20}$

根据已知条件，可得

$$C_{12} + \frac{C_{10}}{2} = 0.018 \quad 2C_{10} = 0.032$$

解得 $C_{10} = C_{20} = 0.016\mu\text{F}$ $C_{12} = 0.01\mu\text{F}$



例题1. 求同轴电缆的绝缘电阻。设内外导体的半径分别为 R_1 、 R_2 ，长度为 L ，并且远远大于截面半径。中间介质的电导率为 γ ，介电常数为 ϵ 。

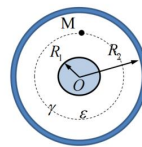
解：设漏电流为 I ，则内外导体间任意点 M 处的漏电流密度为

$$\vec{J} = \frac{I}{2\pi\rho L} \vec{e}_\rho$$

由欧姆定律可得电场强度 $\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\gamma} = \frac{I}{2\pi\gamma\rho L} \vec{e}_\rho$

内外导体之间的电压 $U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{\rho} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{2\pi\gamma\rho L} \vec{e}_\rho \cdot d\vec{\rho} = \frac{I}{2\pi\gamma L} \ln \frac{R_2}{R_1}$

则绝缘电阻为 $R = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi\gamma L} \ln \frac{R_2}{R_1}$



三、电磁场的能量

- 圆柱电容器，极板间填充非理想介质 ϵ, γ ，半径 a ，距离 h ，且 $h \ll a$ ，(1)说明板间电流为传导电流还是位移电流(2)求电容器中的电场、磁场和能流密度（说明大小和方向）(3)求流入电容器的能量。
- 写出复数形式坡印亭定理并说明各项物理意义。阐述与时域坡印亭定理的重点区别。

四、镜像法（4分+）

- 说明镜像法和仿真实验所用的有限元法与有限差分法的区别。

如图所示，无限大平面两侧分别充满介电常数为 ϵ_1 和 ϵ_2 的介质，在距离界面 d 处有一点电荷 q ，则点电荷 q 的受力()

整理得到：

$$\vec{f} = -\frac{(\epsilon_2 - \epsilon_1)q^2}{16\pi\epsilon_1(\epsilon_2 + \epsilon_1)d^2}\vec{e}_z$$
 求介质2的电位，这里不能是 ϵ_1 求解区域的三不变原则，保证符合唯一性定理

q' 取代了 S 面上感应电荷，整个空间变为 ϵ_2
 $\therefore \vec{f} = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \cdot \frac{q q'}{(2d)^2} \vec{e}_z$

$$\vec{f} = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \cdot \frac{(\epsilon_2 - \epsilon_1)q^2}{4d^2} \vec{e}_z$$

A

A $\vec{f} = -\frac{(\epsilon_2 - \epsilon_1)q^2}{16\pi\epsilon_1(\epsilon_2 + \epsilon_1)d^2}\vec{e}_z$
 B $\vec{f} = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_2)q^2}{16\pi\epsilon_1(\epsilon_2 + \epsilon_1)d^2}\vec{e}_z$
 C $\vec{f} = \frac{(\epsilon_2 - \epsilon_1)q^2}{16\pi\epsilon_1(\epsilon_2 + \epsilon_1)d^2}\vec{e}_z$
 D $\vec{f} = \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_2)q^2}{16\pi\epsilon_1(\epsilon_2 + \epsilon_1)d^2}\vec{e}_z$

- 加上沿 z 轴方向的电场 E_0 ，求受力

五、各场的源、势、微分方程和解（12分）

场	源	位函数	满足的微分方程	解或特解
静电场	电荷	$\vec{E} = -\nabla\varphi$	(1)	$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{V'} \frac{\rho_f}{R} dV'$
静磁场	电流	(2)	$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}_C$ 库伦规范: $\nabla \cdot \vec{A} = 0$	$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}_C}{R} dV'$
时变电磁场	电荷和电流	$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ (3)	(4) $\nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}_C$ (5)	$\vec{A} =$ (6) $\varphi =$ (7)
似稳场	(8)	(9)	$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}_C \\ \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho_f}{\epsilon} \end{cases}$ (10)	$\vec{A} =$ (11) $\varphi =$ (12)

六、电磁场的边界条件

- 为什么推导衔接条件不能用微分方程要用积分方程
- 说明时变电磁场时理想导体边界条件的矢量形式。在导体附近的介质内，电力线和磁力线有什么特点。

3 已知磁化强度 $\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J}_M \cdot d\vec{S}$

类比所学知识求衔接条件（说明所学知识）

七、麦克斯韦方程组（23分）

- 电容器两端加上 $u = U_m \cos \omega t$ ，求电容器中的全电流

2.

3. (1) 证明无源自由空间仅随时间变化的场 (例如 $\vec{B} = B_m \sin(\omega t) \vec{e}_z$), 不满足麦克斯韦方程组;

(2) 证明若将 t 换成 $(t - y/c)$, 则可以满足麦克斯韦方程组;